

ПРОГРАММА
ХIII Международной конференции «Кремний-2020»
и XII Школы молодых ученых и специалистов по актуальным проблемам физики,
материаловедения, технологии и диагностики кремния, нанометровых структур и
приборов на его основе
(далее — «Кремний-2020»)

Время	21.09, понедельник	22.09, вторник	23.09, среда	24.09, четверг	25.09, пятница
07:30-08:30	Заезд – заселение с 14:00	Пробежка, зарядка	Пробежка, зарядка	Пробежка, зарядка	–
08:30-09:30		Завтрак / Регистрация участников	Завтрак	Завтрак	Завтрак
09:30-11:30		Пленарная сессия	Работа секций 2, 4, 7, 8	Работа секций 1, 3, 5, 6	Отъезд – освободить номер до 12:00
11:30-12:00		Кофе-брейк	Кофе-брейк	Кофе-брейк	
12:00-14:00		Пленарная сессия	Работа секций 2, 4, 7, 8, обзор стендовых докладов, круглые столы «Вычислительная литография», «Машинное обучение»	Работа секций 1, 3, 5, 6, обзор стендовых докладов, круглые столы «Метрологическая база микроэлектроники», «SPICE-модели»	–
14:00-15:00	Обед	Обед	Обед	Обед	
15:00-19:00	Заезд	Резерв продолжения пленарной сессии/Онлайн доклады/ волейбол	Экскурсия/ футбол	Резерв продолжения работы секций/ Настольные игры	
18:30-19:30	Ужин	Ужин	Ужин	Торжественный ужин (время начала уточняется). Награждение, закрытие	
19:30-21:00	Мафия / Настольные игры	Настольные игры / «Что Где? Когда?»	Настольные / кнопочные игры		
21:00-...	Инстаграм-квест	Инстаграм-квест	Инстаграм-квест		

Пленарная сессия

№ п/п	Время	Доклад	Место проведения
1.	09:30-09:40	Академик РАН Кведер Виталий Владимирович, д.т.н. Итальянцев А.Г. Приветственное слово участникам «Кремния-2020» от организатора АО «НИИМЭ».	
2.	09:40-10:10	Кведер Виталий Владимирович. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ИНЖЕНЕРИИ ДЕФЕКТОВ В МУЛЬТИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ.	
3.	10:10-10:35	Двуреченский Анатолий Васильевич, Якимов Андрей Иннокентьевич, Зиновьева Айгуль Фанизовна, Ненашев Алексей Владимирович, Зиновьев Владимир Анатольевич. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В КРЕМНИЕВЫХ КВАНТОВО-РАЗМЕРНЫХ СТРУКТУРАХ ДЛЯ КОМПОНЕНТ НАНОЭЛЕКТРОНИКИ, НАНОФОТОНИКИ И СПИНТРОНИКИ.	
4.	10:35-11:00	Петросянц Константин Орестович. ВВЕДЕНИЕ В TCAD И SPICE МОДЕЛИРОВАНИЕ П/П ПРИБОРОВ И ЭЛЕМЕНТОВ БИС.	
5.	11:00-11:30	Мурашев Виктор Николаевич. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА СБИС.	
	11:30-12:00	Кофе-брейк	
6.	12:00-12:35	ОНЛАЙН. Kurbangali Baynazarovich Tynyshkybayev, Chistos Spitas, Konstantinos Kostas, Zinetula Zeke Insepov. GRAPHENE LOW-TEMPERATURE SYNTHESIS ON POROUS SILICON	
7.	12:35-12:55	ОНЛАЙН. Науменко Данил Валерьевич, Лысенко Игорь Евгеньевич, Ежова Ольга Александровна. ТРЕХОСЕВОЙ МЭМС АКСЕЛЕРОМЕТР НА ОСНОВЕ ВЫСОКОАСПЕКТНЫХ ТОРСИОННЫЙ ПОДВЕСОВ.	
8.	12:55-13:15	ОНЛАЙН. Зиновьев Владимир Анатольевич, Смагина Жанна Викторовна, Зиновьева Айгуль Фанизовна, Двуреченский Анатолий Васильевич, Мудрый Александр Викторович. ИЗЛУЧАТЕЛЬНАЯ РЕКОМБИНАЦИЯ В ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ Ge/Si С КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ.	
9.	13:15-13:30	ОНЛАЙН. Ду Хаолун. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ МЕМРИСТОРА.	
10.	13:30-13:45	ОНЛАЙН. Кузьмин Павел Андреевич. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТОПОЛОГИИ МИКРОПРОЦЕССОРА С АРХИТЕКТУРОЙ MIPS.	
11.	13:45-14:15	Кобелева Светлана Петровна. Критская Татьяна Владимировна, Шварцман Леонид Яковлевич, Додонов Владимир Николаевич, Кравцов Анатолий Александрович. НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ КРЕМНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ЧИСТОТЫ	

Секция 1 «Материаловедение кристаллического кремния: получение и очистка металлургического кремния, процессы роста из расплавов, химического осаждения из газовой фазы, аппаратура для роста» (доктор физико-математических наук Рошупкин Дмитрий Валентинович, доктор физико-математических наук Итальянцев Александр Георгиевич)

Очные доклады (секция 1)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
1.	09:30-09:50	Непомнящих Александр Иосифович. ВЫСОКОЧИСТЫЙ РАФИНИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КРЕМНИЙ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕМНИЯ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.	
2.	09:50-10:10	Ерёмин Валерий Петрович, Елисеев Игорь Алексеевич. СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КРЕМНИЯ В РОССИИ И МИРЕ, ЕГО РАФИНИРОВАНИЕ ДО ВЫСОКИХ МАРОК И «СОЛНЕЧНОГО» КАЧЕСТВ.	
3.	10:10-10:30	Кобелева Светлана Петровна, Щемеров Иван Васильевич, Шарапов Артем Алексеевич, Юрчук Сергей Юрьевич. УЧЁТ ПОВЕРХНОСТНОЙ РЕКОМБИНАЦИИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ РЕКОМБИНАЦИОННОГО ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ ПО СПАДУ ФОТОПРОВОДИМОСТИ В ОБРАЗЦАХ БОЛЬШОЙ ТОЛЩИНЫ.	
4.	10:30-10:50	Аверкин Андрей Иванович, Козлов Владимир Алексеевич, Николаев Владимир Иванович, Тимашов Роман Борисович, Федоров Максим Вячеславович, Шпейзман Виталий Вениаминович. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ СВЕРХТОНКИХ ПЛАСТИН КРЕМНИЯ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ СПОСОБАМИ ВЫРАЩИВАНИЯ МАТЕРИАЛА ПЛАСТИН И ОБРАБОТКИ ИХ ПОВЕРХНОСТИ.	
5.	10:50-11:10	Редькин Сергей Викторович, Мальцев Петр Павлович, Гамкрелидзе Сергей Анатольевич. КУБИЧЕСКИЙ КАРБИД КРЕМНИЯ НА КРЕМНИИ.	
6.	11:10-11:30	Миланина Ксения Игоревна, Агафонов Андрей Николаевич. ПЛАНАРНЫЕ ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛОНКИ НА КРЕМНИЕВЫХ ПОДЛОЖКАХ.	
	11:30-12:00	Кофе-брейк	

Круглый стол (секция 1)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
	13:00-13:50	Круглый стол «Метрологическая база микроэлектроники» (Кобелева Светлана Петровна, кандидат физико-математических наук (НИТУ «МИСиС»)).	

Стендовые доклады (секция 1)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
7.	–	Логинова Екатерина Максимовна, Лизункова Дарья Александровна. НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЙ КРЕМНИЙ КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ АДРЕСНОЙ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВ.	
8.	–	Полужктова Наталья Алексеевна, Лизункова Дарья Александровна. ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА СВОЙСТВА ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР С НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ КРЕМНИЕМ.	
9.	–	Полужктова Наталья Алексеевна, Латухина Наталья Виленовна, Чепурнов Виктор Иванович, Павликов Александр Владимирович, Головань Леонид Анатольевич. ОПТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КАРБИДИЗИРОВАННЫХ КРЕМНИЕВЫХ НАНОНИТЕЙ.	
10.	–	Абросимова Наталья Дмитриевна, Кипелкин Иван Михайлович, Оболенский Сергей Владимирович. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НИЗКОИНТЕНСИВНОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУР «КРЕМНИЙ НА ИЗОЛЯТОРЕ».	
11.	–	Мазинов Алим Сеит-Аметович, Тютюник Андрей Сергеевич, Гурченко Владимир Сергеевич. СИНТЕЗ И ПРОВОДЯЩИЕ СВОЙСТВА КРЕМНИЙ-УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТРУКТУР ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА.	
12.	–	Наумов Аркадий Валерьевич, Смирнова Наталья Николаевна, Старцев Вадим Валерьевич. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИОННЫХ КЛАСТЕРОВ В МОНОКРИСТАЛЛАХ CZ-Ge ДИАМЕТРОМ 200 ММ, ВЫРАЩЕННЫХ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ.	

Заочные доклады (секция 1)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
13.	–	Павлов Артем Александрович, Серикканов Абай Серикканович, Турмагамбетов Тлеужан Сабиржанович. ОЧИСТКА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ ОТ БОРА И ФОСФОРА ШЛАКОВЫМ РАФИНИРОВАНИЕМ.	
14.	–	Шаропов Уткиржон Баходирович. ЭЛЕКТРОННО-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЕВЫХ ПЛАСТИН.	
15.	–	Кононенко Олег Викторович, Зотов Александр Владимирович, Матвеев Виктор Николаевич. ТУРБОСТРАТНЫЙ МУЛЬТИСЛОЙНЫЙ ГРАФЕН –	

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
		ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ДАТЧИКОВ МАГНИТНОГО ПОЛЯ И ФОТОДЕТЕКТОРОВ	
16.	–	Леньшин Александр Сергеевич, Барков Константин Александрович, Скопинцева Наталья Геннадиевна, Минаков Дмитрий Анатольевич, Середин Павел Владимирович. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МНОГОСЛОЙНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ.	

Секция 2 «Атомные процессы на поверхности, границах раздела и в объеме кремния: дефекты, примесные атомы, гетерограницы» (академик РАН Кведер Виталий Владимирович)

Очные доклады (секция 2)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
1.	09:30-09:50	Терехов Владимир Андреевич, Барков Константин Александрович, Нестеров Дмитрий Николаевич, Попов Анатолий Игоревич, Баринов Алексей Дмитриевич, Середин Павел Владимирович, Голощапов Дмитрий Леонидович, Занин Игорь Евгеньевич, Ивков Сергей Александрович, Домашевская Эвелина Павловна, Козаков Алексей Титович, Никольский Анатолий Викторович. ВЛИЯНИЕ КИСЛОРОДА НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК SIPOS.	
2.	09:50-10:10	Степина Наталья Петровна, Шумилин Андрей Вадимович, Бельтюков Ярослав Михайлович, Двуреченский Анатолий Васильевич, Файнер Надежда Ильинична. ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ МАГНЕТОСОПРОТИВЛЕНИЕ ПЛЕНОК SiC _x N _y :Fe.	
3.	10:10-10:30	Зайцева Эльза Гайнуллаевна, Наумова Ольга Викторовна. СРАВНЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ В ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУРАХ С РАЗНЫМИ КОНСТРУКТИВНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ.	
4.	10:30-10:50	Пономарев Сергей Артемьевич, Рогило Дмитрий Игоревич. СЛОИСТЫЙ IN ₂ SE ₃ НА ПОВЕРХНОСТИ SI(111) С ГИСТЕРЕЗИСАМИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ.	
5.	10:50-11:10	Терехов Владимир Андреевич, Теруков Евгений Иванович, Ундалов Юрий Константинович, Барков Константин Александрович, Середин Павел Владимирович, Голощапов Дмитрий Леонидович, Занин Игорь Евгеньевич, Домашевская Эвелина Павловна. ОЦЕНКА РАЗМЕРОВ НАНОКРИСТАЛЛОВ С ПОМОЩЬЮ КРС СПЕКТРОСКОПИИ В ПЛЕНКАХ a-SiO _x :H ПОСЛЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ НАНОКЛАСТЕРОВ КРЕМНИЯ.	

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
6.	11:10-11:30	Петров Алексей Сергеевич, Рогило Дмитрий Игоревич. СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ Si(111) ПРИ АДСОРБЦИИ SN В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР И ЭЛЕКТРОМИГРАЦИИ.	
	11:30-12:00	Кофе-брейк	

Стендовые доклады (секция 2)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
7.	–	Окулич Евгения Викторовна, Окулич Виктор Иванович, Тетельбаум Давид Исаакович. ОЦЕНКА ДОЗЫ АМОРИФИКАЦИИ КРЕМНИЯ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ПАРАМЕТРОВ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ЛЕГКИМИ ИОНАМИ.	
8.	–	Орлов Андрей Алексеевич, Резванов Аскар Анварович, Гвоздев Владимир Александрович, Кузнецов Павел Игоревич, Серегин Дмитрий Сергеевич. ФОРМИРОВАНИЕ ДИФФУЗИОННЫХ БАРЬЕРОВ В СИСТЕМЕ МЕДНОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИИ В МЕТОДЕ GAP FILLING.	
9.	–	Ромодин Михаил Сергеевич, Баранов Глеб Владимирович, Дорофеев Алексей Анатольевич, Панасенко Петр Васильевич, Сергей Дмитриевич Федотов, Александр Владимирович Царев. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕРЬ В КРЕМНИИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ СВЧ СИГНАЛА.	
10.	–	Мирошкин Ярослав Андреевич, Резванов Аскар Анварович. ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ЧАСТИЦ С ПОВЕРХНОСТЬЮ КРЕМНИЯ В ПРОЦЕССЕ ГЛУБОКОГО КРИОГЕННОГО ТРАВЛЕНИЯ.	

Заочные доклады (секция 2)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
11.	–	Девятков Эдуард Валентинович ПЕРЕНОС ДЖОЗЕФСОНОВСКОГО ТОКА ПОВЕРХНОСТНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЙЛЕВСКИХ ПОЛУМЕТАЛЛОВ	
12.	–	Zukowski Pawel, Koltunowicz Tomasz, Czarnacka Karolina, Федотов Александр Кириллович, Тыщенко Ида Евгеньевна. ТРАНСПОРТ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ ПЛЕНОК SiO ₂ С НАНОЧАСТИЦАМИ InSb.	
13.	–	Тыщенко Ида Евгеньевна. ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПЛЁНОК КРЕМНИЯ НА ИЗОЛЯТОРЕ НАНОМЕТРОВОЙ ТОЛЩИНЫ.	

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
14.	–	Попов Владимир Павлович, Тыщенко Ида Евгеньевна. СТРУКТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИК-ДИЭЛЕКТРИК-ПОЛУПРОВОДНИК ДЛЯ СВЧ, ФОТОННЫХ, НЕЙРОСЕТЕВЫХ И НАНО РАЗМЕРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ.	
15.	–	Золотухин Дмитрий Сергеевич, Голощанов Дмитрий Леонидович, Середин Павел Владимирович, Мизеров А.М., Леньшин Александр Сергеевич. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ БУФЕРНОГО СЛОЯ SiC/por-Si НА СТРУКТУРНЫЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА ГЕТЕРОСТРУКТУР GaN/SiC/Si(111).	

**Секция 3 «Нанотехнологии и тонкие пленки в кремниевой микроэлектронике»
(доктор технических наук Путря Михаил Георгиевич)**

Очные доклады (секция 3)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
1.	09:30-09:50	Домашевская Эвелина Павловна, Терехов Владимир Андреевич, Занин Игорь Евгеньевич, Барков Константин Александрович. ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ МЕТАСТАБИЛЬНОЙ ФАЗЫ Al_3Si ПРИ ИОННО-ЛУЧЕВОМ И МАГНЕТРОННОМ НАПЫЛЕНИИ КОМПОЗИТНЫХ ПЛЕНОК Al-Si.	
2.	09:50-10:10	Редькин Сергей Викторович, Мальцев Петр Павлович, Гамкрелидзе Сергей Анатольевич. ЛАЗЕРНОЕ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОЕ ФРАГМЕНТИРОВАНИЕ ПЛАСТИН НА КРИСТАЛЛЫ.	
3.	10:10-10:30	Лозовой Кирилл Александрович, Дирко Владимир Владиславович. ОБОБЩЕННАЯ КИНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РОСТА ДВУМЕРНЫХ И НУЛЬМЕРНЫХ СТРУКТУР КРЕМНИЯ И ГЕРМАНИЯ.	
4.	10:30-10:50	Кацюба Алексей Владимирович, Двуреченский Анатолий Васильевич, Камаев Геннадий Николаевич, Володин Владимир Алексеевич, Кириенко Виктор Владимирович. РАДИАЦИОННО-СТИМУЛИРОВАННЫЙ РОСТ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК $CaSi_2$.	
5.	10:50-11:10	Долгополов Владимир Миронович, Иракин Павел Александрович, Варакин Виктор Михайлович. УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ПРОЦЕСС ГЛУБОКОГО АНИЗОТРОПНОГО ТРАВЛЕНИЯ КРЕМНИЯ С ВЫСОКИМ АСПЕКТНЫМ СООТНОШЕНИЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ TSV СТРУКТУР.	
6.	11:10-11:30	Евдокимов Владимир Лукьянович. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ НЕРАВНОМЕРНОСТИ СЛОЕВ, ОСАЖДАЕМЫХ ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ, НА МИКРОРЕЛЬЕФНУЮ ПОДЛОЖКУ.	
	11:30-12:00	Кофе-брейк	
	12:00-12:20	Горохов Сергей Александрович. ИССЛЕДОВАНИЕ БАРЬЕРНЫХ СЛОЕВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДНЫХ КОНТАКТНЫХ ОКОН.	

Стендовые доклады (секция 3)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
7.	–	Зюзин Сергей Сергеевич, Горнев Евгений Сергеевич, Резванов Аскар Анварович, Панин Виталий Вячеславович. АТОМНО-СЛОЕВОЕ ОСАЖДЕНИЕ ПЛЁНОК МЕТАЛЛОВ И ИХ ОКСИДОВ.	

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
8.	–	Тихонова Елена Дмитриевна, Горнев Евгений Сергеевич. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛА SPIN-ON-CARBON ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МЕТОДА САМОСОВМЕЩЕННОГО ДВОЙНОГО ПАТТЕРНИРОВАНИЯ.	
9.	–	Татаринцев Андрей Андреевич, Шишлянников Антон Валерьевич, Руденко Константин Васильевич, Рогожин Александр Евгеньевич, Иешкин Алексей Евгеньевич. ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КОНТРАСТОВ ЭЛЕКТРОННОГО РЕЗИСТА HSQ ПРИ РАЗНЫХ МЕТОДАХ ПРОЯВЛЕНИЯ.	
10.	–	Коханенко Андрей Павлович, Дирко Владимир Владиславович, Лозовой Кирилл Александрович. ЗАВИСИМОСТЬ УПРУГИХ НАПРЯЖЕНИЙ ОТ ТОЛЩИНЫ ОСАЖДЕННОГО МАТЕРИАЛА ПРИ РОСТЕ ГЕРМАНИЯ НА КРЕМНИИ.	
11.	–	Кацюба Алексей Владимирович, Двуреченский Анатолий Васильевич, Камаев Геннадий Николаевич, Володин Владимир Алексеевич, Кириенко Виктор Владимирович. КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПЛЕНОК CaSi ₂ , ФОРМИРУЕМЫХ ПРИ РАДИАЦИОННО- СТИМУЛИРОВАННОМ ЭПИТАКСИАЛЬНОМ РОСТЕ CaF ₂ НА Si.	

Заочные доклады (секция 4)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
12.	–	Антонов Валентин Андреевич, Попов Владимир Павлович, Тарков Сергей Михайлович, Тыщенко Ида Евгеньевна. СТРУКТУРНО И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИ СОВЕРШЕННЫЕ ГЕТЕРОПАРЫ КРЕМНИЙ-САПФИР С HIGH-K МЕЖСЛОЙНЫМ ДИЭЛЕКТРИКОМ.	

Секция 4 «Физика кремниевых квантово-размерных структур для нано- и оптоэлектроники, фотоники, спинтроники и логических элементов для квантовых вычислений» (член-корреспондент РАН Двуреченский Анатолий Васильевич)

Очные доклады (секция 4)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
1.	09:30-09:50	Терещенко Алексей Николаевич, Королев Дмитрий Сергеевич, Хорошева Мария Анатольевна, Никольская Алена Андреевна, Михайлов Алексей Николаевич, Белов Алексей Иванович, Тетельбаум Давид Исаакович. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ.	
2.	09:50-10:10	Двуреченский Анатолий Васильевич, Зиновьев Владимир Анатольевич, Зиновьева Айгуль Фанизовна, Ненашев Алексей Владимирович, Кацюба Алексей Владимирович, Мудрый Александр Викторович. УСИЛЕНИЕ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ Ge/Si КВАНТОВЫХ ТОЧЕК В ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СТРУКТУРАХ С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА.	
3.	10:10-10:30	Королев Дмитрий Сергеевич, Никольская Алена Андреевна, Михайлов Алексей Николаевич, Белов Алексей Иванович, Конаков Антон Алексеевич, Муртазин Ренат Ильдарович, Павлов Дмитрий Алексеевич, Тетельбаум Давид Исаакович. ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА ИОННО-СИНТЕЗИРОВАННЫХ СТРУКТУР, СОДЕРЖАЩИХ ФАЗУ 9R-Si.	
4.	10:30-10:50	Кириенко Виктор Владимирович, Якимов Андрей Иннокентьевич, Блошкин Алексей Александрович, Двуреченский Анатолий Васильевич, Уткин Дмитрий Евгеньевич. УСИЛЕНИЕ ФОТОТОКА КОМПОЗИТНЫМИ МЕТАЛЛ-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ МЕТАПОВЕРХНОСТЯМИ В ФОТОПРИЕМНИКАХ НА БАЗЕ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК Ge/Si.	
5.	10:50-11:10	Смагина Жанна Викторовна, Зиновьев Владимир Анатольевич, Степихова Маргарита Владимировна, Рудин Сергей Алексеевич, Родякина Екатерина Евгеньевна, Новиков Алексей Витальевич, Двуреченский Анатолий Васильевич. УПОРЯДОЧЕННЫЕ ГРУППЫ Ge(Si) КВАНТОВЫХ ТОЧЕК НА КНИ-ПОДЛОЖКАХ, ВСТРОЕННЫХ В ФОТОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ.	
6.	11:10-11:30	Камаев Геннадий Николаевич, Ашихмина Маргарита Андреевна, Черкаев Алексей Сергеевич. ПРОВОДИМОСТЬ КРЕМНИЕВЫХ МЕЗАРЕЗИСТОРОВ В УСЛОВИЯХ ДЖОУЛЕВА РАЗОГРЕВА.	
	11:30-12:00	Кофе-брейк	

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
7.	12:00-12:20	Миннуллин Рамиль Талгатович, Барабаненков Михаил Юрьевич. СПЕКТР ОТРАЖЕНИЯ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ ИЗ GESBTE НА ВОЛНОВОДЕ СТРУКТУРЫ КРЕМНИЙ-НА-ИЗОЛЯТОРЕ.	

Стендовые доклады (секция 4)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
8.	–	Черкова Светлана Глебовна, Володин Владимир Алексеевич, Скуратов Владимир Алексеевич, Кривякин Григорий Константинович, Камаев Геннадий Николаевич. МОДИФИКАЦИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ ОТЖИГАМИ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДЕФЕКТОВ В КРЕМНИИ, ОБЛУЧЕННОМ ТЯЖЕЛЫМИ ИОНАМИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ.	

Заочные доклады (секция 4)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
9.	–	Зиновьев Владимир Анатольевич, Зиновьева Айгуль Фанизовна, Кацюба Алексей Владимирович, Володин Владимир Алексеевич, Двуреченский Анатолий Васильевич. ОСОБЕННОСТИ РОСТА СЛОЕВ CaSi ₂ НА ПОДЛОЖКАХ CaF ₂ /Si(001).	

Секция 5 «Моделирование процессов роста кремния и структур на его основе, применение TCAD и SPICE моделей» (доктор технических наук Петросянец Константин Орестович, кандидат физико-математических наук Морозов Александр Юрьевич)

Очные доклады (секция 5)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
1.	09:30-09:45	Орленсон Вульф Борисович, Мазинев Алим Сеит-Аметович, Шевченко Алексей Иванович. МОДЕЛЬ РАСЧЁТА ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ ПОГЛОЩЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ.	
2.	09:45-10:00	Попов Дмитрий Александрович. TCAD МОДЕЛИРОВАНИЕ СБООУСТОЙЧИВОСТИ SELBOX И DSOI КМОП КНИ ЯЧЕЕК ПАМЯТИ.	

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
3.	10:00-10:15	Исмаил-Заде Мамед Рашидович, Самбурский Лев Михайлович. SPICE МОДЕЛИ СУБМИКРОННЫХ КМОП ТРАНЗИСТОРОВ В ДИАПАЗОНЕ КРИОГЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.	
4.	10:15-10:30	Звягинцев Дмитрий Евгеньевич, Куликов Никита Андреевич, Харитонов Игорь Анатольевич, Самбурский Лев Михайлович. ИЗМЕРЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЦИФРОВЫЕ КМОП ИС.	
5.	10:30-10:45	Шипицин Дмитрий Святославович, Потупчик Александр Георгиевич, Шемякин Александр Валерьевич. ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ БЛИЗОСТИ В ГЛУБОКО-СУБМИКРОННЫХ МОП-ТРАНЗИСТОРАХ И ПОДХОДЫ К ИХ УЧЁТУ В SPICE-МОДЕЛЯХ.	
6.	10:45-11:00	Коротких Семён Андреевич, Новиков Антон Алексеевич, Ильин Сергей Алексеевич. ВАЛИДАЦИЯ В КРЕМНИИ СРЕДСТВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СБИС.	
7.	11:00-11:15	Константинов Вячеслав Сергеевич, Итальянцев Александр Георгиевич. ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФАЗ В ДИОКСИДЕ ГАФНИЯ.	
8.	11:15-11:30	Шипицин Дмитрий Святославович, Потупчик Александр Георгиевич, Яшин Георгий Алексеевич. КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ СОЗДАНИИ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ТРАНЗИСТОРОВ Н-ТИПА, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ КНИ 0,18 МКМ.	
	11:30-12:00	Кофе-брейк	

Круглый стол (секция 5)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
	13:00-13:50	Круглый стол «SPICE-модели» (Петросянц Константин Орестович, доктор технических наук (МИЭМ НИУ ВШЭ))	

Заочные доклады (секция 5)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
9.	–	Ларионов Михаил Юрьевич, Соболев Александр Сергеевич, Резник Анатолий Юрьевич. МЕТАМАТЕРИАЛ С ПОВЫШЕННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В RFID-МЕТКЕ.	
10.	–	Шипицин Дмитрий Святославович, Потупчик Александр Георгиевич, Нуштаев Алексей Владимирович. ВЛИЯНИЕ ВЕОЛ НА БЫСТРОДЕЙСТВИЕ СХЕМ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ КНИ250, КНИ180, КНИ90.	

Секция 6 «Кремниевая электронная компонентная база для нанoeлектроники, оптоэлектроники, силовой электроники, светоизлучающих структур, фотоприемников, микромеханики и сенсорики» (доктор технических наук Мурашев Виктор Николаевич)

Очные доклады (секция 6)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
1.	09:30-09:50	Иванов Дмитрий Николаевич, Леонов Алексей Владимирович, Мурашев Виктор Николаевич. ЭФФЕКТ ЗАРЯДОВОЙ СВЯЗИ В ПОЛЕВОМ ЭЛЕМЕНТЕ ХОЛЛА НА ОСНОВЕ ТОНКОПЛЕНОЧНОГО КНИ МОП ТРАНЗИСТОРА.	
2.	09:50-10:10	Наумова Ольга Викторовна, Зайцева Эльза Гайнуллаевна, Асеев Александр Леонидович, Генералов Владимир Михайлович, Сафатов Александр Сергеевич. КРЕМНИЕВЫЕ НАНОПРОВОЛОЧНЫЕ СЕНСОРЫ С ДИЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ АНАЛИТА.	
3.	10:10-10:30	Соловьев Андрей Владимирович. ЗАРУБЕЖНЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ЭКБ.	
4.	10:30-10:50	Филиппов Иван Фёдорович, Вертегел Валерий Викторович, Гимпилевич Юрий Борисович. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА SI СВЧ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ.	
5.	10:50-11:10	Дученко Николай Владимирович, Поморев Андрей Сергеевич, Харитонов Семен Алексеевич, Ковалевский Денис Сергеевич, Ветров Игорь Леонидович. АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ФАЗОВОЙ ОШИБКИ В КВАДРАТУРНЫХ МОДУЛЯТОРЕ И ДЕМОДУЛЯТОРЕ РАЗРАБОТАННЫХ ПО КМОП ТЕХНОЛОГИИ.	
6.	11:10-11:30	Чуйко Андрей Викторович. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛНОВОГО ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ГИРОСКОПА.	
	11:30-12:00	Кофе-брейк	
7.	12:00-12:20	Соловьев Александр Анатольевич. РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО ПОЛНОГО НАБОРА ЛОГИЧЕСКИХ ВЕНТИЛЕЙ НА ОСНОВЕ МЭМС.	
8.	12:20-12:40	Михайлов Виктор Юрьевич, Пронин Алексей Александрович. РЕАЛИЗАЦИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ И РАДИОЛОКАЦИИ В ЕДИНОМ КОРПУСЕ.	
9.	12:40-13:00	Горчакова Мария Алексеевна, Кочетков Дмитрий Валерьевич. ЦИФРОВОЙ УМНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ С ПОДАВЛЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЭФФЕКТОВ ПЕРВОГО ПОРЯДКА ДЛЯ БАЗОВОГО МАТРИЧНОГО КРИСТАЛЛА НА БАЗЕ КНИ 90НМ.	

Стендовые доклады (секция 6)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
10.	–	Баранцев Андрей Сергеевич, Баранов Глеб Владимирович, Волосов Анатолий Викторович, Нефедьев Сергей Васильевич, Россов Александр Сергеевич. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНТЕГРИРОВАННЫХ В КРЕМНИЕВЫЙ ИНТЕРПОЗЕР КОНДЕНСАТОРОВ ДЛЯ 3D СВЧ МОДУЛЕЙ.	
11.	–	Макиевский Юрий Александрович. ИССЛЕДОВАНИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ СВЧ СХЕМАМИ В ППМ АФАР.	
12.	–	Скуратов Илья Дмитриевич, Панасенко Пётр Васильевич, Баранов Глеб Владимирович, Балаклеяский Николай Сергеевич. АНАЛИЗ ИНТЕГРАЛЬНОГО ОПТИЧЕСКОГО СВЧ-ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ.	
13.	–	Хрущева Ольга Александровна. ВЛИЯНИЕ МЕТАЛЛОВ НА РЕЗОНАНСНУЮ ЧАСТОТУ И ДАЛЬНОСТЬ СЧИТЫВАНИЯ ОБЪЕМНОЙ РАДИОЧАСТОТНОЙ МЕТКИ.	
14.	–	Эпов Илья Владимирович. ВЛИЯНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕМНОЙ КОРОТКОЗАМКНУТОЙ UHF МЕТКИ.	
15.	–	Тярин Андрей Сергеевич, Эннс Александр Викторович. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОГО ФИЛЬТРА-ДЕЦИМАТОРА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ДЕЛЬТА-СИГМА АЦП.	
16.	–	Дубовицкий Константин Александрович, Зубов Игорь Александрович, Ермаков Игорь Владимирович. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ В КМОП-ТЕХНОЛОГИИ 180 НМ.	
17.	–	Кочетков Дмитрий Валерьевич, Белоусов Егор Олегович, Моленкамп Ксения Михайловна, Эннс Александр Викторович. ВЫСОКОЛИНЕЙНЫЙ СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ 12-РАЗРЯДНЫЙ ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВОИЧНО-ВЗВЕШЕННЫХ КЛЮЧЕЙ.	
18.	–	Любавин Кирилл Дмитриевич, Лосевской Александр Юрьевич, Ермаков Игорь Владимирович. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЧАСТИ RFID-МЕТКИ.	

Заочные доклады (секция 6)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
19.	–	Шабанов Андрей Александрович, Путря Михаил Георгиевич. ИССЛЕДОВАНИЕ И АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ МИКРОСХЕМ В РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ НА ОСНОВАНИИ КРИТИЧЕСКОЙ СОВОКУПНОСТИ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.	

Секция 7 «Искусственный интеллект и нейророботные системы» (кандидат технических наук Тельминов Олег Александрович)

Очные доклады (секция 7)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
1.	09:30-09:50	Панин Геннадий Николаевич. РЕЗИСТИВНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В НИЗКОРАЗМЕРНЫХ КРИСТАЛЛАХ ДЛЯ НЕЙРОПОДОБНЫХ СИСТЕМ.	
2.	09:50-10:10	Морозов Александр Юрьевич, Абгарян Каринэ Карленовна, Ревизников Дмитрий Леонидович. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЙРОМОРФНОЙ СЕТИ НА МЕМРИСТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ С 1T1R КРОССБАР АРХИТЕКТУРОЙ.	
3.	10:10-10:30	Макаров Михаил Эрнстович, Сапегин Александр Андреевич, Королев Дмитрий Сергеевич. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯЧЕЙКИ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ ПАМЯТИ С ОПТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ.	
4.	10:30-10:50	Шамин Евгений Сергеевич, Горнев Евгений Сергеевич, Жевненко Дмитрий Алексеевич, Мещанинов Федор Павлович, Кожевников Владислав Сергеевич. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ МЕМРИСТОРА.	
5.	10:50-11:10	Мошкарлова Лилия Айратовна, Тельминов Олег Александрович. МЕТОДЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ В ЗАДАЧЕ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ РЕКУРРЕНТНЫМИ НЕЙРОННЫМИ СЕТЯМИ С ДОЛГОЙ КРАТКОСРОЧНОЙ ПАМЯТЬЮ.	
6.	11:10-11:30	Березин Александр Андреевич, Шахманова Мария Владимировна, Иванов Владимир Викторович. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННОЙ КОМБИНАТОРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ В ЗАДАЧЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ ЭСКИЗА ФОТОШАБЛОНА.	
	11:30-12:00	Кофе-брейк	

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
7.	12:00-12:20	Федотов Михаил Игоревич, Коротичский Виктор Иванович, Ковешников Сергей Викторович. РАЗРАБОТКА СЕЛЕКТОРНЫХ ПРИБОРОВ НА ОСНОВЕ ДВУСЛОЙНЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ ДЛЯ МАТРИЦ РЕЗИСТИВНОЙ ПАМЯТИ.	
8.	12:20-12:40	Окулич Евгения Викторовна, Гусейнов Давуд Вадимович, Королев Дмитрий Сергеевич, Белов Алексей Иванович, Окулич Виктор Иванович, Тетельбаум Давид Исаакович, Михайлов Алексей Николаевич. ГИБКИЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОФОРМОВКИ И РЕЗИСТИВНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В МЕТАЛЛОКСИДНЫХ МЕМРИСТИВНЫХ УСТРОЙСТВАХ, СОДЕРЖАЩИХ ФИЛАМЕНТЫ.	
9.	12:40-13:00	Трясогузов Павел Евгеньевич, Теплов Георгий Сергеевич, Кузовков Алексей Валерьевич. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИИ ЭФФЕКТОВ ОПТИЧЕСКОЙ БЛИЗОСТИ АЛГОРИТМАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ.	

Круглый стол (секция 7)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
	13:00-13:50	Круглый стол «Машинное обучение» (Тельминов Олег Александрович, кандидат технических наук (АО «НИИМЭ»))	

Стендовые доклады (секция 7)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
10.	–	Ганыкина Екатерина Андреевна, Горнев Евгений Сергеевич, Резванов Аскар Анварович. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ В HFO ₂ RRAM-СТРУКТУРАХ В ПРОЦЕССЕ RESET.	
11.	–	Матюшкин Игорь Валерьевич, Рубис Павел Дмитриевич. КЛЕТОЧНО-АВТОМАТНЫЕ АЛГОРИТМЫ ГЕНЕРАЦИИ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ.	
12.	–	Кузнецов Сергей Евгеньевич, Теплов Георгий Сергеевич. МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕМРИСТОРА С УЧЁТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОТКЛОНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ РЕЗИСТИВНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ.	

Заочные доклады (секция 7)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
13.	–	Отажонов Салим Мадрахимович, Алимов Нодир Эсоналиевич, Ботиров Кадыр Абдуллаевич.	

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
		ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ CdTe–SiO ₂ –Si.	
14.	–	Орлов Олег Михайлович, Гисматулин Андрей Андреевич, Гриценко Владимир Алексеевич. МЕМРИСТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ТОНКИХ СЛОЕВ Si ₃ N ₄ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕНОСА ЗАРЯДА В НИХ.	

Секция 8 «Системы автоматизированного проектирования» (Иванов Владимир Викторович, кандидат физико-математических наук Колдаев Игорь Михайлович)

Очные доклады (секция 8)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
1.	09:30-09:50	Колдаев Игорь Михайлович. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КОМПОНЕНТ КРЕМНИЕВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ.	
2.	09:50-10:10	Балан Никита Николаевич, Иванов Владимир Викторович, Панкратов Александр Львович, Харченко Екатерина Леонидовна. МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ВКЛАДА ДОПУСКОВ НА КРИТИЧЕСКИЕ ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТОЧНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ РИСУНКА ФОТОШАБЛОНА В БЮДЖЕТЫ ЛИТОГРАФИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ.	
3.	10:10-10:30	Шарапов Андрей Анатольевич, Шамин Евгений Сергеевич, Скуратов Илья Дмитриевич, Горнев Евгений Сергеевич. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОПТИМИЗАЦИИ ФОТОЛИТОГРАФИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ЭФФЕКТОВ ШЕРОХОВАТОСТИ БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАНОСТРУКТУР. ПОСТАНОВКА И ОБОСНОВАНИЕ ЗАДАЧИ.	
4.	10:30-10:50	Коротких Семён Андреевич. МЕТОДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ МАРШРУТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ БИБЛИОТЕК СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.	
5.	10:50-11:10	Сахашик Ульяна Андреевна, Соколова Евгения Васильевна. РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ БИБЛИОТЕКИ ТЕСТОВЫХ СТРУКТУР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ SMO.	
6.	11:10-11:30	Харченко Екатерина Леонидовна, Соколова Евгения Васильевна. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ТЕСТОВЫХ ЯЧЕЕК ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В MPW ЗАПУСК.	
7.	11:30-12:00	Кофе-брейк	

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
	12:00-12:20	Литаврин Михаил Владимирович, Горнев Евгений Сергеевич, Матюшкин Игорь Валерьевич. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА САМООРГАНИЗАЦИИ DSA-ЛИТОГРАФИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ.	

Круглый стол (секция 8)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
	12:30-13:50	Школа молодых ученых по вычислительной литографии НИИМЭ (Горнев Евгений Сергеевич, член-корреспондент РАН, Иванов Владимир Викторович (АО «НИИМЭ»))	

Стендовые доклады (секция 8)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
8.	–	Медведев Константин Александрович, Панкратов Александр Львович, Иванов Владимир Викторович. КОНЦЕПЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФОТОШАБЛОНОВ.	

Заочные доклады (секция 8)

№ п/п	Время	Доклад: (номер заявки) авторы, название	Место проведения
9.	–	Петросянц Константин Орестович, Кожухов Максим Владимирович. УНИФИЦИРОВАННАЯ SPICE-МОДЕЛЬ БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА, УЧИТЫВАЮЩАЯ ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАДИАЦИИ.	
10.	–	Моисеев Григор Альфредович. МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ БЕСПЕРЕХОДНОГО ТРАНЗИСТОРА В СИСТЕМЕ TCAD.	
11.	–	Соколова Евгения Васильевна, Харченко Екатерина Леонидовна. РАЗРАБОТКА БИБЛИОТЕКИ ТЕСТОВЫХ СТРУКТУР ДЛЯ СЛОЯ КОНТАКТНЫЕ ОКНА ДЛЯ SMO.	

Экскурсии (по предварительному заказу)

Вариант 1. Никитский сад, подвалы Массандры			
1.	14:45	Выезд на экскурсию по Никитскому саду	400 / 250 руб. (пенс.)
2.	17:00	Экскурсия и дегустация в подвалах Массандры (9 образцов вин)	750 руб.
3.	–	Трансфер с экскурсионным рассказом	700 руб.

4.	19:00	Прибытие к ужину	
Вариант 2. Никитский сад, Гурзуфский винзавод			
1.	14:45	Выезд на экскурсию по Никитскому саду	400 / 250 руб. (пенс.)
2.	17:00	Экскурсия на Гурзуфский винзавод и дегустация (9 образцов вин)	600 руб.
3.	–	Трансфер с экскурсионным рассказом	700 руб.
4.	19:00	Прибытие к ужину	
Вариант 3. Массандровский дворец с дегустацией			
1.		Массандровский дворец с дегустацией	500 / 300 руб. (пенс.)
2.		Трансфер с экскурсионным рассказом	700 руб.
Вариант 4. Два дворца: Ливадийский и Массандровский			
1.	1,5 часа	Экскурсия	450 / 250 руб. (пенс.)
2.	1,5-2 часа	Трансфер с экскурсионным рассказом	700 руб.
Вариант 5. Парк Парадиз (Айвазовского)			
1.		Экскурсия	800 / 400 руб. (пенс.)
2.		Трансфер с экскурсионным рассказом	400 руб.